知識天地

章詠湟博士後研究、吳豐宇博士生、李連忠副研究員(原子與分子科學研究所)

摘要

我們以(NH₄)2MoS₄為前驅物,分別使用海綿^[1]和石墨烯保護之三維鎳發泡結構^[2]兩種材料為基材,利用低溫化 學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition, CVD)製程,成功製作出三維結構硫化鉬(MoSx)之高效率產氫元件。成長在 石墨烯保護之三維鎳發泡結構基材的非晶結構MoSx,在標準氫電位(RHE)偏壓為0.2V時,量測得302 mL g⁻¹ cm⁻² h⁻¹ (13.47 mmol g⁻¹ cm⁻² h⁻¹) 之高效率產氫速率;而成長在海綿基材之MoSx,亦測得72 mA/cm²之高電流密度。三維結 構基材不但提高表面積大小,更加增進催化劑的盛載量,進而提升電催化產氫效率。而低溫成長之MoSx材料,因 為具有大量的架橋S₂²或是頂點S²結構,是為產氫反應地點,因此具有極佳之催化活性。

內容

氫能源在反應過程中不會產生不必要的汙染物,被視為最具潛力可望取代石化能源 的選項之一。雖然貴金屬例如白金(Pt)具有良好的產氫效率,但是稀有性和昂貴的價格 阻礙了他在工業上的應用。最近無機催化劑MoS,,由於材料的低廉價格,較高的化學 穩定性,在氫能源產生上傑出的光催化與電催化性質…等等特性,受到廣大的注意。為 改善產氫的能力,大部分研究均投入材料改值、複合材料研發或是奈米結構的建造。 近日,MoS,/ 還原石墨烯複合材料成功地被研發出來,石墨烯除了拿來乘載催化劑之 外,其高導電率亦增進電催化效率。然而,大部分報導依然以二維平面結構為主。為提 升產氫電催化效率,應致力於有效地增加表面積以供催化劑沉積。因此,發展三維電極 結構是件刻不容緩的事。雖然藉由鎳發泡結構並利用化學氣象沉積法(CVD)^[31],三維石 墨烯發泡結構已被成功製備,但是沒有鎳發泡作為骨幹,易脆的三維石墨烯發泡結構不 能作為電極盛載催化劑。然而如此,三維鎳發泡結構具備良好的導電性,低廉的價格, 較高的表面積,是作為承載催化劑的理想材料[32-34]。但是,三維鎳發泡結構卻不耐酸性 溶液,而一般電催化產氫實驗均在酸溶中進行,是故不適合作為工作電極。因此,我們 提出在三維鎳發泡結構上成長石墨烯之結構,藉以保護金屬骨架,以避免酸性溶液的侵 蝕,增加它在酸性溶液的穩定性。此外,在三維基材設計上,我們亦提出以海綿為骨架 之結構,以降低製成程序與成本。而三維結構之基材,其優越的表面積將有效地增加催 化劑的盛載量,進而提升電催化產氫效率。



圖→ MoSx成長於石墨烯保 護之三維錄發泡結構之產氫 影像,鑲崁圖為三維MoSx電 子顯微鏡影像。



MoSx成長於海綿基材

之產氫影像,鑲崁圖展示其

昌

可饒式結構。

以石墨烯保護之三維鎳發泡結構為基材實驗中,三維鎳發泡結構首先在1050°C,氫 氣(100 sccm)環境下,進行半小時的還原反應以去除鎳發泡表面的氧化物,接著在CH₄: H₂=15:100sccm,500mtorr,1050°C環境下進行1小時石墨烯成長。在完成石墨烯成長後,

在電子顯微鏡(SEM)影像中,可清楚觀察到石墨烯均匀分布的皺紋結構,並以拉曼光譜確認石墨烯為多層結構。 將石墨烯保護之三維鎳發泡結構在酸性溶液進行電催化產氫測試,不但可以長時間於酸性溶液中工作,亦更進一 步證實石墨烯對產氫不具任何貢獻,說明接下來的產氫反應均來自於MoSx催化劑。在完成石墨烯保護之三維鎳發 泡結構後,將5 wt%的(NH₄)₂MoS₄前驅物均匀塗布在上面,並在100°C加熱板進行10分鐘烤乾。接著放置於H₂:Ar = 20:80sccm,500 torr,溫度為100、120、170、200、250、300°C環境下1小時,進行MoSx成長。在完成MoSx成長 後,在電子顯微鏡影像中,可清楚觀察到MoSx均匀分布的奈米顆粒結構,並以拉曼光譜確認是為MoSx結構。

電催化產氫為三端電極結構,其中Ag/AgCl為參考電極(reference electrode),石墨棒為對電極(counter

electrode),三維MoSx/石墨烯/錄發泡為工作電極(working electrode),並於在0.5M H₂SO₄溶液,掃描速度為5 mV/S之下進行實驗。在極化曲線(polarization curves)量測中,標準氫電位偏壓為0.2V時,120°C製備的MoSx展現出最傑出之電流密度(44 mA/cm2),最低之42.8數值的塔佛斜率(Tafel plot)。因此,MoSx電催化兩階段產氫反應機制,可視為沃爾默_海洛夫斯基反應(Volmer_Heyrovsky reaction),亦即首先是放電反應接著為電化學脫附步驟。而經X射線光電子能譜(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)分析,高溫製成之MoS2只具備S²結構,而低溫製成之MoSx除了具有S²結構之外,還擁有S₂²結構。更有文獻指出架橋S₂²或是頂點S²結構,是為產氫反應地點,尤其是S₂²結構。因此,具有大量S₂²結構。更有文獻指出架橋S₂²或是頂點S²結構,是為產氫反應地點,尤其是S₂²結構。因此,具有大量S₂²結構之的傳輸效率,也降低在傳輸過程中載子的損耗,進而提升電催化效率。與其他炭材料(例如:炭布,炭紙,石墨墊)相比較之下,石墨烯保護的三維錄發泡結構不但具有高表面積,而且可以乘載較大量的MoSx催化劑。因此,在偏壓為0.2V的標準氫電位之下,120°C低溫製成的MoSx可以量測得302 mL g⁻¹ cm⁻² h⁻¹ (13.47 mmol g⁻¹ cm⁻² h⁻¹)之高效率產氫速率。

以海綿為基材實驗中,MoSx製備方式如上述,並以移液管(pipet)固定MoSx塗布在海綿之質量,製程溫度分別為120°C、1000°C以及1000–120°C之複合溫度(完成1000°C製程之後接著120°C製程)。即使在1000°C高溫製程下, 塗布MoSx的海綿結構依然存在,且呈現易脆狀態;而在120°C低溫製程下,MoSx/海綿呈現可饒式結構。極化曲 線量測中,在偏壓為0.2V標準氫電位時,1000–120°C MoSx/海綿展現出最傑出之電流密度(72 mA/cm²),其次為 1000°C(26 mA/cm²),最差為120°C(3 mA/cm²)。於先前描述可知,低溫製程之MoSx具有大量S₂²結構,因而展現較 為傑出之電催化活性;相反的,高溫製程之MoSx只有S²結構,因此電催化活性較為微弱。雖然如此,相較於 120°C MoSx/海綿,1000°C MoSx/海綿卻展現較高的電流密度。這可能是歸因於120°C MoSx/海綿較高之電阻率 (8.7 × 10¹⁰ Ω cm),而1000°C MoSx/海綿卻展現較高的電流密度。這可能是歸因於120°C MoSx/海綿較高之電阻率 (8.7 × 10¹⁰ Ω cm),而1000°C MoSx/海綿卻只有19.6 Ω cm。因此,為求得最佳結構組態,先製備1000°C MoSx以提 升其導電能力,接著塗佈120°C MoSx以增進其電催化能力。而電化學阻抗譜(electrochemical impedance spectroscopy, EIS)更進一步指出,1000–120°C MoSx/海綿展現出最小值之電荷轉移電阻(charge-transfer resistance)為3.425 Ω cm², 其次為1000°C(8.254 Ω cm²),最差為120°C(21.82 Ω cm²),其結果與極化曲線量測一致。此結果也說明1000–120°C MoSx/海綿具有最快速的介面電子轉移和最低的電荷再結合現象,而此複合溫度結構也提升了電催化產氫的動力 學,因而有較傑出的電催化活性。

我們提出了三維基材結構的設計概念,藉以提升催化劑的盛載量,以改善產氫效率;亦在低溫環境下製備催 化劑,企圖增加S₂²結構含量,以提升催化劑本身的電催化活性。實驗結果將可藉為參考,設計下一個更優異的電 催化產氫元件。

Reference:

[1] Yung-Huang Chang, Cheng-Te Lin, Tzu-Yin Chen, Chang-Lung Hsu, Yi-Hsien Lee, Wenjing Zhang, Kung-Hwa Wei, Lain-Jong Li, Adv. Mater. 2013, 25, 756–760.

[2] Yung-Huang Chang, Feng-Yu Wu, Tzu-Yin Chen, Chang-Lung Hsu, Chang-Hsiao Chen, Ferry Wiryo, Kung-Hwa Wei, Chia-Ying Chiang, Lain-Jong Li, small 2013, DOI: 10.1002/smll.201302407.